

三菱半導体(トランジスタ) 2SB1035

低周波電力増幅用
シリコンPNPエピタキシャル形

概要

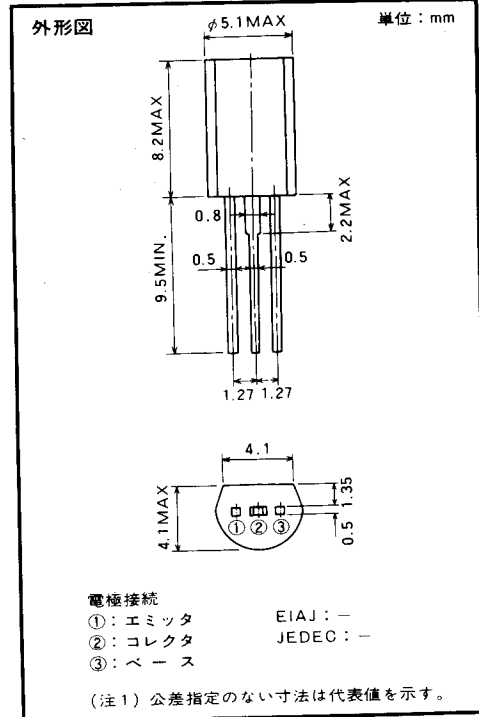
2SB1035は、樹脂封止形のシリコンPNPエピタキシャル形トランジスタで、特にコレクタ損失およびコレクタ電流が大きく設計、製造されており、2~3.5W出力の低周波電力増幅用として2SD1447とコンプリメンタリで使用するのに最適です。

特長

- コレクタ損失が大きい $P_{Cmax}=900mW$
- コレクタ電流が大きい $I_{CM}=-1.5A$
- h_{FE} の直線性がよい
- 利得帯域幅積が高い $f_T=100MHz$ 標準

用途

ラジオ、テープレコーダ、小形ステレオ等の2~3.5W出力の低周波電力増幅回路



最大定格 (Ta=25°C)

記号	項目	定格値	単位
V _{CB0}	コレクタ・ベース間電圧	-30	V
V _{EB0}	エミッタ・ベース間電圧	-4	V
V _{CE0}	コレクタ・エミッタ間電圧	-25	V
I _{CM}	せん頭コレクタ電流	-1.5	A
I _C	コレクタ電流	-1	A
P _C	コレクタ損失 (Ta=25°C)	900	mW
T _j	接合部温度	+150	°C
T _{stg}	保存温度	-55 ~ +150	°C

電気的特性 (Ta=25°C)

記号	項目	測定条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
V _{(BR)CB0}	コレクタ・ベース降伏電圧	I _C =-10μA, I _E =0	-30		-	V
V _{(BR)EB0}	エミッタ・ベース降伏電圧	I _E =-10μA, I _C =0	-4			V
V _{(BR)CE0}	コレクタ・エミッタ降伏電圧	I _C =-100μA, R _{BE} =∞	-25			V
I _{CB0}	コレクタしゃ断電流	V _{CB} =-25V, I _E =0			-1	μA
I _{EB0}	エミッタしゃ断電流	V _{EB} =-2V, I _C =0			-1	μA
h _{FE} †	直流電流増幅率	V _{CE} =-1V, I _C =-500mA	55		300	-
V _{CE(sat)}	コレクタ・エミッタ飽和電圧	I _C =-500mA, I _B =-25mA			-0.5	V
f _T	利得帯域幅積	V _{CE} =-6V, I _E =10mA		100		MHz

†: h_{FE}の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

アイテム	C	D	E
h _{FE}	55~110	90~180	150~300